

26.09.03

World Intellectual Property Organization
PCT Division
34 Chemin des Colombettes
1211 Geneva 20
Switzerland

第19条（46規則）の規定に基づく請求の範囲の補正

国際出願番号：PCT/JP03/04866

国際出願日：16.04.03

出願人：名称 三菱住友シリコン株式会社
あて名 日本国東京都港区芝浦一丁目2番1号
代理人：氏名 5937 弁理士 生形 元重
あて名 日本国大阪府大阪市中央区瓦町4丁目6番15号
電話番号 06-6201-3851

拝 啓

16.04.03提出の上記国際出願に係る国際調査報告を受領した出願人は、第19条（1）の規定に基づく補正を、別添のとおり、提出する。

第19条（1）の規定に基づく補正の提出書面は、上記国際出願の「請求の範囲」が記載された全ての頁（45頁、46頁、47頁）の差し替え用紙である。ここでは、請求の範囲第7項及び第17項を補正し、他の項（第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項、第8項、第9項、第10項、第11項、第12項、第13項、第14項、第15項、第16項）は変更しない。

出願人は、また、補正の簡単な説明を、別添のとおり、提出する。

敬 具

生 形 元 重



添付書類：

(1) 第19条（1）に基づく補正書	1通
(2) 簡単な説明	1通

請求の範囲

1. 100Ωcm以上の抵抗率を有する高抵抗シリコンウエーハであつて、ウエーハ内部に0.2μmサイズ以上の酸素析出物(BMD)が1
5 $\times 10^4$ 個/cm² 以上の密度で形成され、ウエーハ中の酸素濃度が 12×10^{17} atoms/cm³ (ASTM F-121, 1979) 以下であり、炭素濃度が 0.5×10^{16} atoms/cm³ 以上である高
下であり、炭素濃度が 0.5×10^{16} atoms/cm³ 以上である高
抵抗シリコンウエーハ。
2. 前記ウエーハ表面上で観察される0.12μmサイズ以上のLPD
10 (Light Point Defect) 密度が0.2個/cm² 以
下に制御された請求の範囲第1項記載の高抵抗シリコンウエーハ。
3. 100Ωcm以上の抵抗率を有する高抵抗シリコンウエーハであつて、セコエッチングによって検出されるgrown-in欠陥の密度が
15 1×10^3 cm⁻³ 以下であり、ウエーハ内部に0.2μmサイズ以上の
酸素析出物(BMD)が 1×10^4 個/cm² 以上の密度で形成され、
ウエーハ中の酸素濃度が 12×10^{17} atoms/cm³ (ASTM
F-121, 1979) 以下である高抵抗シリコンウエーハ。
4. 前記ウエーハ中の炭素濃度が 0.5×10^{16} atoms/cm³ 以
上である請求の範囲第3項記載の高抵抗シリコンウエーハ。
- 20 5. 前記ウエーハ表面から少なくとも5μm以上の深さにわたってDZ
(Denuded Zone) 層が形成された請求の範囲第1項又は第
3項記載の高抵抗シリコンウエーハ。
6. 前記抵抗率が100Ωcm以上300Ωcm未満、300Ωcm以
上2000Ωcm未満、2000Ωcm以上の各範囲にあるウエーハ中
25 の酸素濃度(ASTM F-121, 1979)の値が、それぞれ12
 $\times 10^{17}$ atoms/cm³ 以下、 7×10^{17} atoms/cm³ 以下

、 5. 8×10^{17} atoms/cm³ 以下の範囲に制御された請求の範囲第 1 項又は第 3 項記載の高抵抗シリコンウエーハ。

7. (補正後) 抵抗率が 100 Ω cm 以上で、酸素濃度が 12×10^{17} atoms/cm³ (ASTM F-121, 1979) 以上、炭素濃度が 0.5×10^{16} atoms/cm³ 以上である初期シリコンウエーハを用い、これに酸素析出核形成熱処理及び酸素析出物成長熱処理を施すことにより、前記ウエーハ中の残存酸素濃度を 12×10^{17} atoms/cm³ (ASTM F-121, 1979) 以下に制御することを特徴とする高抵抗シリコンウエーハの製造方法。

10 8. 抵抗率が 100 Ω cm 以上で、酸素濃度が 14×10^{17} atoms/cm³ (ASTM F-121, 1979) 以上であり、且つセコエッチングによって検出される grown-in 欠陥の密度が 1×10^3 cm⁻³ 以下である初期シリコンウエーハを用い、これに酸素析出核形成熱処理及び酸素析出物成長熱処理を施すことにより、前記ウエーハ中の残存酸素濃度を 12×10^{17} atoms/cm³ (ASTM F-121, 1979) 以下に制御することを特徴とする高抵抗シリコンウエーハの製造方法。

15 9. 前記酸素析出核形成熱処理が 500 ~ 900 °C の温度で 5 時間以上の低温熱処理である請求の範囲第 7 項又は第 8 項記載の高抵抗シリコンウエーハの製造方法。

20 10. 前記低温熱処理の条件が 700 ~ 900 °C × 5 時間以上である請求の範囲第 9 項記載の高抵抗シリコンウエーハの製造方法。

11. 前記酸素析出物成長熱処理が 950 ~ 1050 °C の温度で 10 時間以上の高温熱処理である請求の範囲第 7 項又は第 8 項記載の高抵抗シリコンウエーハの製造方法。

25 12. 前記酸素析出核形成熱処理の前に、前記ウエーハに 1100 ~ 1

250℃の温度範囲で1～5時間の酸素外方拡散熱処理を施すことを特徴とする請求の範囲第7項又は第8項記載の高抵抗シリコンウェーハの製造方法。

13. 前記酸素外方拡散熱処理を窒素含有ガス雰囲気で行うことを特徴とする請求の範囲第12項記載の高抵抗シリコンウェーハの製造方法。
5

14. 前記酸素外方拡散熱処理を水素ガス又はアルゴンガス若しくはこれらの混合ガス雰囲気で行うことを特徴とする請求の範囲第12項記載の高抵抗シリコンウェーハの製造方法。

15. 前記酸素析出核形成熱処理の前に、前記ウェーハに急速昇温熱処理を行うことを特徴とする請求の範囲第7項又は第8項記載の高抵抗シリコンウェーハの製造方法。
10

16. 前記急速昇温熱処理の条件が窒素含有雰囲気中で1150～1300℃×1～60秒である請求の範囲第15項記載の高抵抗シリコンウェーハの製造方法。

17. (補正後) 前記初期シリコンウェーハ中の炭素濃度が 0.5×10^{16} atoms/cm³以上である請求の範囲第8項記載の高抵抗シリコンウェーハの製造方法。
15